

EW-Series

Eiko

水冷MBE装置

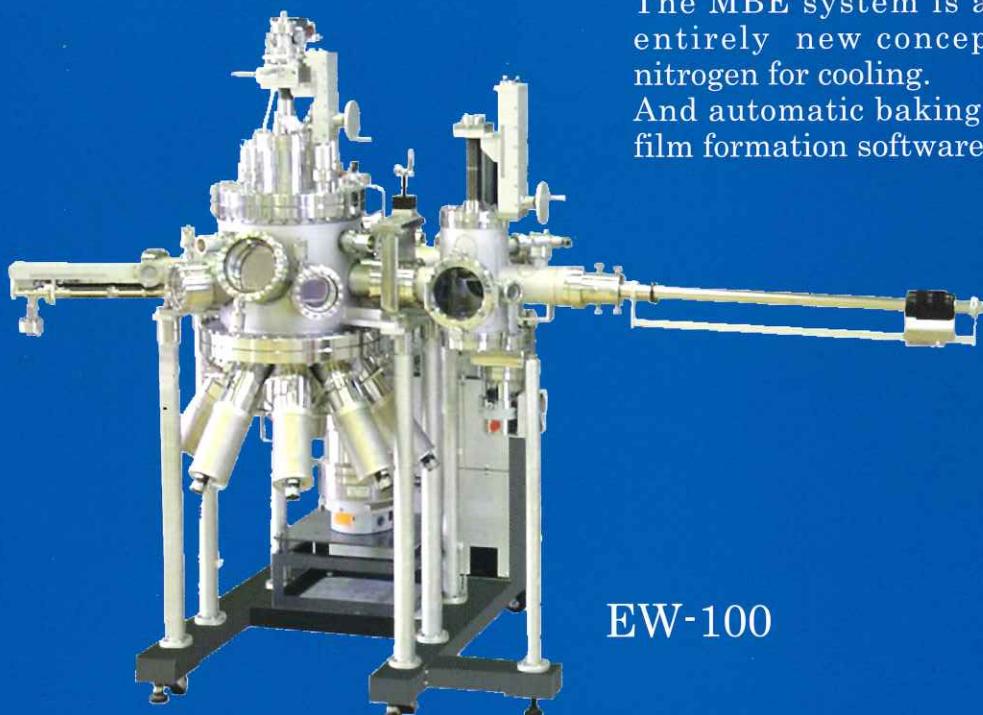
Water Cooling MBE System

本MBEは液体窒素を使用しない、全く新しいコンセプトのもとに開発した装置です。

自動ベーキング機構と自動成膜ソフトにも対応可能です。

The MBE system is a device developed by our entirely new concept. It does not use liquid nitrogen for cooling.

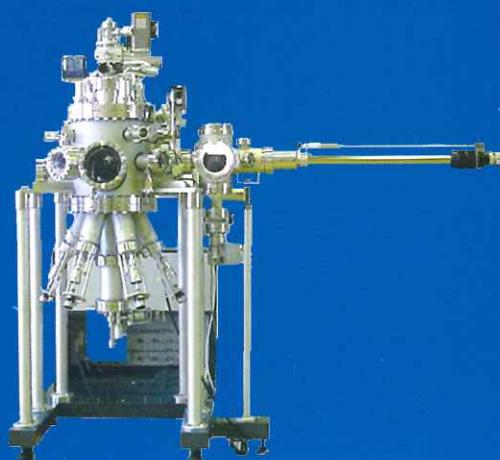
And automatic baking mechanism and automatic film formation software are available.



EW-100



EW-3



EW-10



EW-500

Features

1

液体窒素の要らないMBEです。 MBE system without using liquid nitrogen.

- 液体窒素用シュラウドがありません。液体窒素を使用しなくても容易に 10^{-8} Pa 或いはそれ以上の真圧度を得ることができます。
- 標準装備としてセル用ソースフランジとは別に径の異なるサービスポートを組み合わせたソースフランジもオプションとして用意されています。その中から各々の目的に応じたフランジを選択することにより、EBガンもスパッタリングガンも使用できるようになります。応用範囲は格段と広がります。
- 万一漏水事故が発生しても、チャンバー内には水が入らない構造になっています。
- There is no shroud assembly for liquid nitrogen. 10^{-8} Pa or more can be easily achieved even though liquid nitrogen is not used.
- The system includes a chamber with source flanges for effusion cells as standard equipment. The combination of different size of source flange for use with such as EB gun and sputter gun is available as an optional extra. Consequently EB gun and sputter gun are usable and the system has a much broader range of applications.
- In case water leakage accidentally occurs, the system adopts watertight construction in the pumping system.

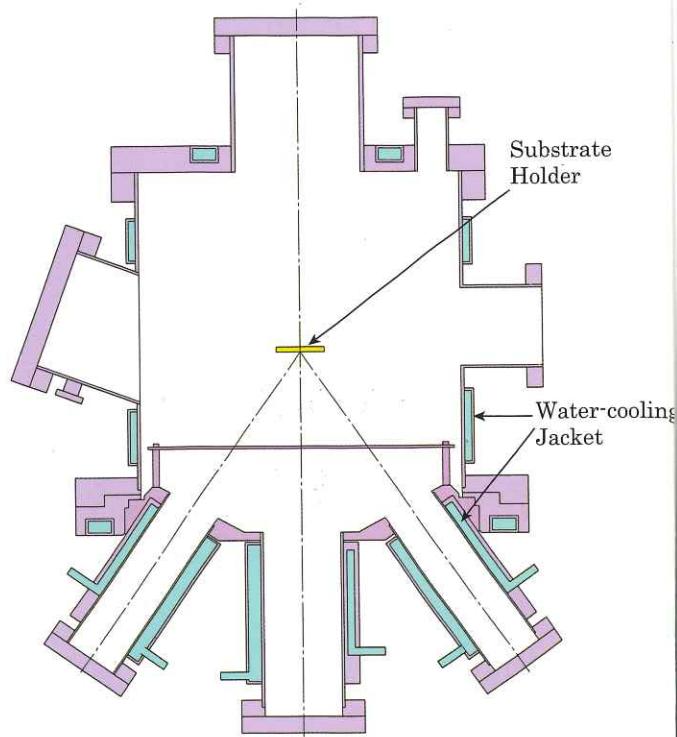


Fig.1 Sectional view of chamber

2

高い膜質制御と優れた操作性 High film quality control and excellent operation performances.

- 排気操作、セルの温度制御、シャッターコントロール等は自動化され、液晶表示パネルに集中表示されます。
- オプションとして別途用意されているアクセサリーを取り付けますと、RHEED パターン、ラジカル源分光スペクトラム、残留ガススペクトラム (Q-mass) 等を PC 上で観察、コントロールすることができる様になります。
- ロードロックチャンバーに予備加熱やラジカル源の取り付けも可能です。
- 独自のヒーター構造により、高い温度均一性を有します。
- Operations of pumping, cell temperature, shutter etc. are automatically controlled. Each operation can be performed on a LCD screen.
- RHEED pattern, spectrum by radical beam source, spectrum by mass spectrometer etc. can be observed and controlled on the LCD operation screen.
- Preheating mechanism and radical beam source can be mounted onto the loading lock chamber.
- High temperature uniformity is available by unique heater configuration.

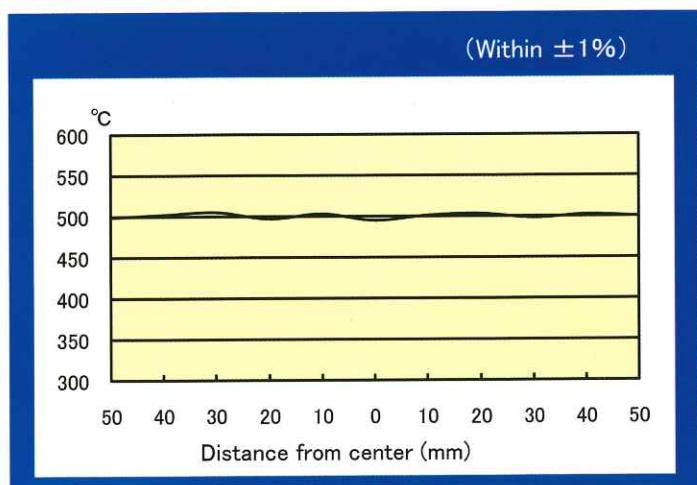


Fig.2 Temperature distribution of manipulator

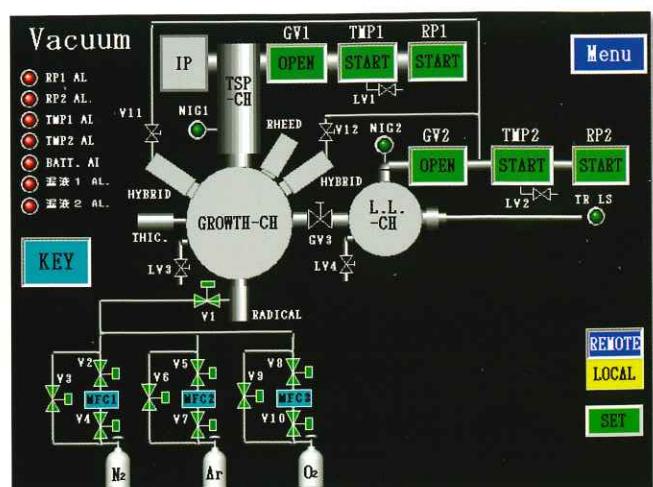


Fig.3 LCD operation screen for vacuum control

Option



Beam Flux Monitor



RHEED



EB Gun



Effusion Cell



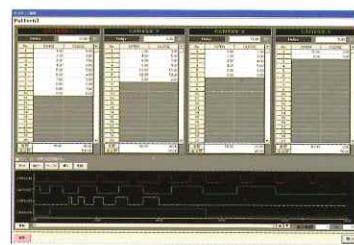
Sputter Gun



Radical Beam Source



Thickness Monitor

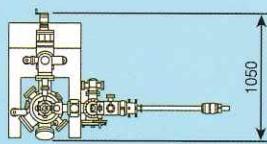


Software for Shutter Controller

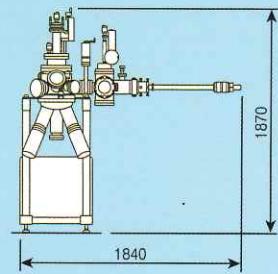


Software for Automatic
Thin Film Formation

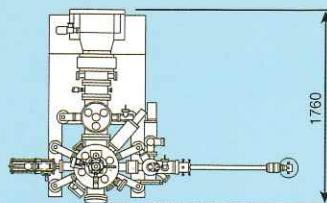
External dimensions



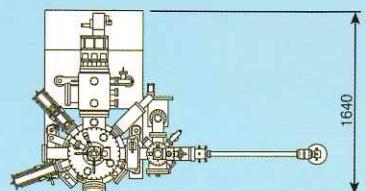
EW-3



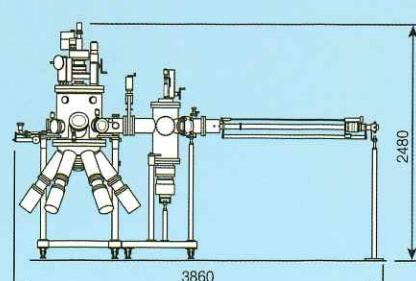
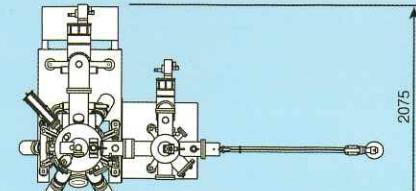
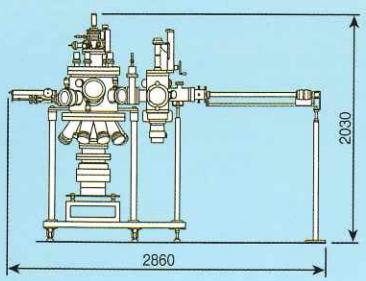
EW-10



EW-100



EW-500



Specifications

Description	EW-3	EW-10	EW-100	EW-500			
チャンバー Chamber	チャンバーサイズ Dimensions	305(dia.)×250mm(h)	406(dia.)×450mm(h)	560(dia.)×500mm(h)	560(dia.)×600mm(h)		
	到達圧力 Ultimate pressure	10 ⁻⁷ Pa range	10 ⁻⁸ Pa range				
基板ホルダー Substrate holder	基板サイズ Substrate size	1 inch in diameter	2 inch in diameter	2 inch in diameter	100mm square		
	基板加熱温度 Maximum temperature	1000°C(Tantalum Heater) / 800°C(Lamp Heater)					
	X 軸 X-axis		±5mm				
	Y 軸 Y-axis		±5mm				
	Z 軸 Z-axis	±10mm					
	傾斜 Inclination	±2°	±3°				
排気系 Evacuation	面内回転 In-plane rotation	360°モーター駆動 (Motor drive)					
	ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump	345 ℥/sec	1400 ℥/sec				
ロードロックチャンバー Lord Lock chamber	ロータリーポンプ Rotary pump	162 ℥/min	345 ℥/min				
	到達圧力 Ultimate pressure	10 ⁻⁴ Pa range		10 ⁻⁵ Pa range			
	基板装着枚数 Number of substrate loaded	2 pieces	2 pieces	2 pieces	4 pieces		
	ターボ分子ポンプ Turbo molecular pump	55 ℥/sec	55 ℥/sec	345 ℥/sec			
	ロータリーポンプ Rotary pump	90 ℥/min	90 ℥/min	162 ℥/min			
ベーキングシステム Baking System	基板搬送 Substrate transfer	ransfer rod (マグネットイックフィールドスルー又はラックピニオンタイプ) Transfer rod (Magnetic feed through or rack pinion type)					
	加熱温度 Heating temperature	200°C Maximum					
オプション Option	ヒーター Heater	チャンバーはランプヒーター又はシースヒーター For the chamber, the lamp heater or sheath heaters.					
	ビームフラックスモニター Beam flux monitor	ヌードゲージ仕様、移動機構付 Nude gauge method and with movement mechanism					
	膜厚モニター Thickness Monitor	ペーカブルセンサー、オシレーター付 With bakeable sensor and oscillator					
Components		RHEED,Effusion cell,EB gun, Radical beam source					

Eiko EIKO ENGINEERING,LTD **Eiko EIKO Corporation**

〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎 50 番地
50 Yamazaki Hitachinaka Ibaraki 311-1251 Japan
PHONE (029) 265-7401 FAX (029) 265-7406
E-mail eiko-eng@1974eiko.co.jp
http://www.1974eiko.co.jp

本社 Head office
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-10-7 フェスタビル2F
FESTA Building 2F 2-10-7,Kajicho,Chiyoda-ku,
Tokyo 101-0044,Japan
PHONE(03)5297-1031 FAX(03)5297-1035
E-mail contact@1974eiko.co.jp

関西営業所 Kansai office
〒650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町 30 常盤ビル 602
602 Tokiwa Bldg. 30 Akashicho Chuo-ku Kobe Hyogo 650-0037 Japan
PHONE (078) 327-7551 FAX (078) 327-7558

茨城営業所 Ibaraki office
〒311-1251 茨城県ひたちなか市山崎 50 番地
50 Yamazaki Hitachinaka Ibaraki 311-1251 Japan
PHONE (029) 265-7401 FAX (029) 265-7406